日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

13.11.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 5月29日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-152276

[ST. 10/C]:

[JP2003-152276]

RECEIVED

9 JAN 2004

WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

出光興産株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年12月22日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

IDK1520A

【提出日】

平成15年 5月29日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

H05B 33/14

【発明者】

【住所又は居所】・千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

【氏名】

福岡賢一

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

【氏名】

松浦 正英

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

【氏名】

山本 弘志

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

【氏名】

細川 地潮

【特許出願人】

【識別番号】

000183646

【氏名又は名称】

出光興産株式会社

【代理人】

【識別番号】

100086759

【弁理士】

【氏名又は名称】

渡辺 喜平

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-333812

【出願日】

平成14年11月18日

21,000円

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013619

【納付金額】

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0200131

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と、

少なくとも第一ホスト材料と第一ドーパントからなる第一発光層と、 少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントからなる第二発光層と、 陰極と、

をこの順序に含み、

前記第一ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}1$ 、前記第一ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gd}1$ 、前記第二ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び前記第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gd}2$ が下記式を満たし、

かつ、前記第一発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I 1 及び前記第二発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I 2 が下記式を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

E_{gh}1>E_{gd}1 E_{gh}2>E_{gd}2 E_{gd}1>E_{gd}2 I1>3.5×I2

【請求項2】 I1>5×I2の関係を満たすことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

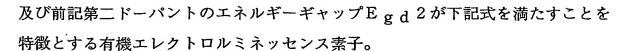
【請求項3】 $E_{gd} 2>2$. 7 e Vであることを特徴とする請求項1又は 2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 陽極と、

少なくとも第一ホスト材料と第一ドーパントからなる第一発光層と、 少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントからなる第二発光層と、 陰極と、

をこの順序に含み、

前記第一ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}1$ 、前記第一ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gd}1$ 、前記第二ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}2$



 $E_{gh} 1 > E_{gd} 1$ $E_{gh} 2 > E_{gd} 2$ $E_{gd} 1 > E_{gd} 2 > 2. 7 e V$

【請求項5】 前記第一発光層において、前記第一ホスト材料に対する前記第一ドーパントの割合が0.1~10mol%であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 前記第二発光層において、前記第二ホスト材料に対する前記 第二ドーパントの割合が0.1~10mol%であることを特徴とする請求項1 ~5のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 前記第一又は第二ホスト材料の少なくとも一方が、下記一般式 [1] で表わされる化合物であることを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】

$$\left(Ar^{1}\right)_{m}\left(X\right)_{p}$$
 [1]

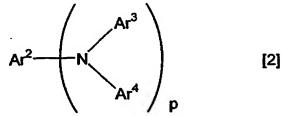
[式中、 Ar^{1} は核炭素数 $6\sim50$ の芳香族環であり、Xは置換基である。

 $mは1\sim5$ の整数、 $nは0\sim6$ の整数である。 $m\geq2$ の時、Arはそれぞれ同じでも異なっていても良い。 $n\geq2$ の時、Xはそれぞれ同じでも異なっていても良い。]

【請求項8】 前記第一ホスト材料と前記第二ホスト材料が同一であることを特徴とする請求項1~7のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】 前記第一又は第二ドーパント材料の少なくとも一方が、下記一般式[2]で表わされる化合物であることを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化2】



[式中、 $A r^2 \sim A r^4$ は置換又は無置換の核炭素数 $6 \sim 50$ の芳香族基、置換又は無置換のスチリル基であり、 $p t 1 \sim 4$ の整数である。 $p \ge 2$ の時、 $A r^3$ 、 $A r^4$ はそれぞれ同じでも異なっていても良い。]

【請求項10】 前記第一発光層の膜厚が、10nm以上であることを特徴とする請求項1~9のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子

【請求項11】 前記第二発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I 2 が、 I 2 = 0 であることを特徴とする請求項 $1 \sim 1$ 0 のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項12】 前記第二発光層と陰極の間に電子注入層を設け、この電子注入層の電子移動度が、 10^{-4} c m 2 / $(V\cdot 7)$ 以上であること有することを特徴とする請求項 $1\sim 11$ のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項13】 前記電子注入層が、含窒素複素環誘導体からなる有機化合物を含むことを特徴とする請求項12に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項14】 前記含窒素複素環誘導体からなる有機化合物が、イミダゾ ピラジン誘導体及び/又はイミダゾール誘導体であることを特徴とする請求項1 3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、詳しくは発光層が二層構造の有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】

電界発光を利用したエレクトロルミネッセンス素子(以下、エレクトロルミネッセンスを「EL」と略記する。)は、自己発光のため視認性が高く、かつ完全 固体素子であるため、耐衝撃性に優れる等の特長を有することから、各種表示装 置における発光素子としての利用が注目されている。

このEL素子には、発光材料に無機化合物を用いてなる無機EL素子と、有機 化合物を用いてなる有機EL素子とがあり、このうち特に有機EL素子は、印加 電圧を大幅に低くし得る上に、フルカラー化が容易であって、消費電力が小さく 、面発光が可能であることから、次世代の発光素子として開発がなされている。

[0003]

有機EL素子の構成については、図3に示すように、陽極/発光層/陰極の構成を基本とする。

この有機EL素子10は、陽極12と陰極13からなる一対の電極の間に発光層14を狭持している。発光層14は通常複数の層を積層したものである。この素子10は、両電極12,13間に電界が印加されると、陰極13側から電子が注入され、陽極12側から正孔が注入される。そして、電子と正孔が発光層14において再結合し、励起状態を生成し、励起状態が基底状態に戻る際にエネルギーを光として放出する。

図4は、図3の有機EL素子のエネルギーダイアグラムを示す。図4において、発光層14のエネルギーレベルである価電子レベルEV0 (HOMO)と伝導レベルEC0 (LUMO)が示されている。陽極12側から正孔が入り、陰極13側から電子が入り、これら正孔と電子が発光層14内で結合して発光する。

[0004]

上記の構成を基礎とし、これに正孔注入・輸送層や電子注入層を適宜設けたもの、例えば、陽極/正孔注入・輸送層/発光層/陰極や、陽極/正孔注入・輸送層/発光層/電子注入層/陰極の構成のものが知られている。

ここで、発光層は以下の機能を併せ持つものである。

① 注入機能;電界印加時に陽極又は正孔注入層より正孔を注入することがで



- ② 輸送機能;注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる機能
- ③ 発光機能;電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能 【0005】

また、正孔注入・輸送層は、陽極より正孔を注入し、有機発光層へこれを輸送 する機能を有し、さらに、正孔注入層/正孔輸送層と別々に作製することもある 。電子注入層は陰極より電子を注入し、有機発光層へこれを輸送する機能を有す る。

[0006]

発光層での発光をより強くするため、蛍光分子 (ドーパント) を微量添加する 技術が知られている。

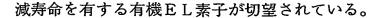
図5は、ドーパントが添加された有機EL素子のエネルギーダイアグラムを示す。この図において、EChはホストの伝導レベル、EVhはホストの価電子レベル、ECdはドーパントの伝導レベル、EVdはドーパントの価電子レベルを示す。また、Eghはホストのエネルギーギャップ(EChとEVhの差)、Egdはドーパントのエネルギーギャップ(ECdとEVdの差)を示す。

ドーパントは、励起したホストのエネルギーを効率よく受け取り発光効率を高める。

[0007]

有機EL素子の発光を多色化する方法としては、大きく分けて以下の3種類の方法がある。

- ① 有機EL素子から放出される白色発光を、赤色、緑色及び青色の三種類のカラーフィルターを用いて三色の光に分けて取り出す方法
- ② 青色EL素子から放出される青色発光を、発光層の光取り出し側に設けた 蛍光層により、青色光を色変換し多色化する方法
- ③ 青色、赤色、緑色の発光層を同一の基板上に並置して多色化する方法 これらの方法において、高輝度かつ長寿命の有機EL素子が求められている。 例えば、①や②の方法では、青緑色系や白色のプロードバンド(幅広いスペクト ル)発光を行う有機EL素子で、初期輝度数百 n i t に対し、数万時間以上の半



[0008]

このような要望に対し、種々の素子構成が検討されている。

その中のひとつの方法として、有機発光層を多層化することにより白色又はブロードバンド発光を得る方法が以下のように提案されている。

- ① 有機発光層を二層構造にして、陽極側の第一発光層をアルミ錯体化合物からなる青色の発光層とし、陰極側の第二発光層を赤色蛍光性物質を含有するアルミ錯体化合物からなる赤色の発光層として白色光を取り出す方法(例えば、特許文献1参照。)
- ② 有機発光層を二層構造にして、陽極側の第一発光層をジスチリルアリーレン系化合物からなる青色の発光層とし、陰極側の第二発光層を緑色発光するアルミ錯体化合物に赤色蛍光性物質を添加した発光層として白色光を取り出す方法(例えば、特許文献2参照。)
- ③ アルミ錯体からなる電子輸送性の化合物とジアミン化合物からなる正孔輸送性の化合物との混合層からなる発光層に、ドーパントとしてクマリン及びルブレンを含有させて、緑色成分及び橙色成分を有する発光を得る方法(例えば、特許文献3参照。)
- ④ ジスチリルアリーレン系化合物からなるホスト材料に、二種以上の色系統の異なる蛍光性物質をドーピングすることにより二層の発光層を形成する方法(例えば、特許文献4参照。)

[0009]

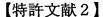
これらの従来技術は、複数種類のドーパントを同等に発光させてブロードバンド発光又は白色を得ようとする方法であり、有機EL素子から発光される光は様々な波長を混合したものである。

しかし、多層積層構成の有機EL素子において、色純度の高いナローバンド (幅の狭いスペクトル)発光であって寿命の長い有機EL素子は知られていない。

[0010]

【特許文献1】

欧州特許第0643549号明細書



米国特許第5503910号明細書

【特許文献3】

国際公開第98/08360号パンフレット

【特許文献4】

特開平12-68057号公報

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記課題に鑑み、色純度の高いナローバンド発光をし、長寿命である 有機EL素子を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】

この課題を解決するために、本発明者は、少なくとも二層の発光層を有する有機EL素子において、第二発光層の発光を抑えること又は二層の発光層が一定の関係を満たした場合に、色純度及び/又は素子の寿命を向上できることを見出し、本発明を完成させた。

[0013]

本発明の第一の態様によれば、陽極と、少なくとも第一ホスト材料と第一ドーパントからなる第一発光層と、少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントからなる第二発光層と、陰極と、をこの順序に含み、第一ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}1$ 、第一ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gd}1$ 、第二ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} なが下記式を満たし、かつ、第一発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I 1 及び第二発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I 2 が下記式を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。

$$E_{gh} 1 > E_{gd} 1$$

 $E_{gh} 2 > E_{gd} 2$

$$E_{gd}1>E_{gd}2$$

$I 1 > 3. 5 \times I 2$

[0014]

本発明の第二の態様によれば、陽極と、少なくとも第一ホスト材料と第一ドーパントからなる第一発光層と、少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントからなる第二発光層と、陰極と、をこの順序に含み、第一ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}1$ 、第一ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}1$ 、第二ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ E_{g} d 2が下記式を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。

$$E_{gh} 1 > E_{gd} 1$$
 $E_{gh} 2 > E_{gd} 2$
 $E_{gd} 1 > E_{gd} 2 > 2. 7 eV$

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明の第一の有機EL素子は、陽極と、少なくとも第一ホスト材料と第一ドーパントからなる第一発光層と、少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントからなる第二発光層と、陰極と、をこの順序に含み、第一ホスト材料のエネルギーギャップEgh1、第一ドーパントのエネルギーギャップEgd1、第二ホスト材料のエネルギーギャップEgh2及び第二ドーパントのエネルギーギャップEgd1、第二ホスト材料のエネルギーギャップEgh2が下記式を満たし、かつ、第一発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I1 及び第二発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 I2 が下記式を満たす。

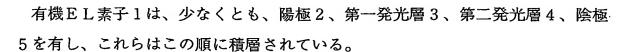


図2は、有機EL素子1のエネルギーダイアグラムである。

このエネルギーダイアグラムには、陽極 2、第一発光層 3、第二発光層 4 及び陰極 5 のエネルギーレベルが示されている。また、第一ホスト材料のエネルギーギャップ E_{gh} 1、第一ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} 1、第二ホスト材料のエネルギーギャップ E_{gh} 2 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} 2 が示されている。

ここでエネルギーギャップとは、有機EL材料の価電子レベルと伝導レベルの エネルギー差に相当するものであり、通常その材料の光吸収スペクトルにおける 吸収端から求められる。

[0017]

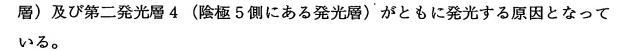
図2に示すように、本発明では、第一ドーパントと、第二ドーパントをそれぞれ異なる発光層3,4にドーピングし、発光層を二層構成とすることで、エネルギーギャップが大きいドーパントを含む第一発光層3を主に発光させる構成にしている。

通常、一層の発光層中に二種類のドーパントを含有させた場合、それらのドーパント間の距離が近いためエネルギー移動が起こりやすく、二種類のドーパントがそれぞれ発光するか、若しくはエネルギーギャップが小さい方のドーパントのみが発光するのが普通である。エネルギーギャップが大きいドーパントのみを発光させることはきわめて困難である。

[0018]

しかしながら、発光層を二層構造にするだけでは、従来技術の例から判るように、第一発光層 3、第二発光層 4 がともに発光するため、色純度が高くなるナローバンド発光は得られない。

この原因の一つとしては、正孔と電子の再結合が起こる位置の問題がある。発 光層に注入された正孔は電子との再結合により、陰極 5 側に進むにつれて濃度が 減少していくが、一部は陰極 5 の近くまで達していると考えられている。このた め、陰極 5 側付近にも再結合領域が存在し、第一発光層 3 (陽極 2 側にある発光



[0019]

そこで、本発明においては、色純度を低下させる原因である、エネルギーギャップの小さいドーパントを含む発光層の発光を抑制する方法として、再結合確率が高い陽極2側に第一発光層3を設け、再結合確率が低い陰極5側に第二発光層4を設ける構造としてある。これにより、第一発光層3を主に発光させ、第二発光層4の発光を十分小さくなるようにできる。

[0020]

さらに本発明においては、第二発光層 4 と陰極 5 の間に電子注入層を設け、この電子注入層の、電界強度(E)が $1\times10^5\sim10^6$ V/c mの電界領域における電子移動度が、 10^{-4} c m 2 / (V・秒)以上であることが好ましい。

このような電子移動度の電子注入層を設けることで、発光領域をより安定して 第一発光層3内に設定することができる。従って、第一発光層3をより選択的に 発光させることができるため、より色純度の良いナローバンド発光を得ることが でき、かつ、顕著に長寿命化できる。

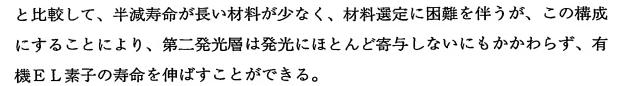
[0021]

尚、電子移動度の測定法としては、Time of flight法(有機膜内の電荷の走行時間の測定から算出する方法)や、空間制限電流の電圧特性から算出する方法等がある [Electronic Process in Organic Crystals (M. Pope, C. E. Swenberg)、Organic Molecular Solids (W. Jones)参照]。本明細書においては、Time of flight法により算出している。具体的には、ITO/有機層(電子注入層等)/Alの構成としたものについて、光照射により生じる過渡電流の時間特性(過渡特性時間)を測定し、以下の式により電子移動度を算出している。

電子移動度=(有機層厚)²/(過渡特性時間·電界強度)

[0022]

一般に、エネルギーギャップの大きい材料はエネルギーギャップが小さい材料



[0023]

この有機EL素子1において、第一ホスト材料のエネルギーギャップ(E_{gh} 1)は、第一ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} 1より大きい。即ち、 E_{gh} 1)と E_{gd} 1の関係を満たす。

第一ドーパントのエネルギーギャップEgdlは、2.7eVより大きいことが好ましい。一般に、エネルギーギャップが大きいドーパントは、小さいドーパントに比べて有機EL素子の半減寿命が短いものが多い。従って、フルカラーで用いる純青色の有機EL素子は、特に長寿命化が困難であったが、本発明は上記の構成を採ることにより極めて長寿命な純青色発光が得られる。

[0024]

第二発光層は、少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントを含んでいる。

第二ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}2$ は、第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gd}2$ より大きい。即ち、 $E_{gh}2>E_{gd}2$ の関係を満たす。

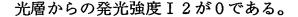
[0025]

第一ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} 1 は、第二ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} 2 より大きいこと、即ち、 E_{gd} 1> E_{gd} 2 の関係を満たす。

また、第二ドーパントのエネルギーギャップ E_{gd} 2は2.7 e Vより大きいこと、即ち、 E_{gd} 2>2.7 e Vの関係を満たすことが好ましい。これにより、フルカラー用の色純度が高い青色発光の有機EL素子を作製できる。

[0026]

この有機EL素子は、第一発光層に由来する光の発光スペクトルの発光極大波長の発光強度I1と、第二発光層に由来する光の発光スペクトルの発光極大波長の発光強度I2が、I1>3.5×I2の関係を満たす。この関係を満たすことにより、色純度の良いナローバンド発光を得ることができる。好ましくはI1>5×I2、さらに好ましくはI1>10×I2である。特に好ましくは、第二発



このように、第二発光層の発光が有機EL素子全体の発光に対し、ほとんど寄与しない場合でも、有機EL素子の寿命を長寿命化できる。

一般にエネルギーギャップが小さい材料程、長寿命な材料が多く、材料の選定が容易である。従って、ブロードバンド発光や白色発光用のEL素子は長寿命素子構成を見出すことが比較的容易だった。

しかし、ナローバンド発光、特に青色発光は、長寿命な材料系を選定することが困難であり、特にフルカラー用途に適した純青色発光材料はこれまでほとんど報告されていなかった。本発明はこれまで知られていた純青色発光材料を長寿命化する技術である。つまり、長寿命であることが知られている材料をあえて、発光層に隣接させて用い、しかもそこからの発光を極力制限することにより、EL素子の長寿命化を行う技術である。

[0027]

 $E_{gh} 1 > E_{gd} 1$ $E_{gh} 2 > E_{gd} 2$ $E_{gd} 1 > E_{gd} 2 > 2. 7 eV$

即ち、基本的な構成については、上記で説明した有機EL素子と同様である。

[0028]

この有機E L素子は、E g d 1>E g d 2>2. 7 e V の関係を満たす。この関係を満たすため、上記の有機E L素子とは異なり、第一発光層及び第二発光層がともに発光しても、どちらも青色発光するため、色純度の高い青色発光を得ることが可能である。

しかも、このような素子構成にすることにより、第一の発明と同様に有機EL



[0029]

第一発光層と第二発光層に用いられるホスト材料は、それぞれ長寿命な発光材料として公知のものを用いることが可能であるが、一般式 [1] で示される材料を発光材料のホスト材料として用いることが好ましい。

【化3】

$$\left(Ar^{1}\right)_{m}\left(X\right)_{n}$$
 [1]

[式中、A r l は核炭素数 $6 \sim 5 0$ の芳香族環であり、X は置換基である。 mは $1 \sim 5$ の整数、 n は $0 \sim 6$ の整数である。 m ≥ 2 の時、A r l はそれぞれ

mは1~5の整数、nは0~6の整数である。m≥2の時、Ar r はそれぞれ 同じでも異なっていても良い。n≥2の時、Xはそれぞれ同じでも異なっていて も良い。]

[0030]

Ar¹として具体的には、フェニル環、ナフチル環、アントラセン環、ビフェニレン環、アズレン環、アセナフチレン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、アセフェナンスリレン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、ナフタセン環、ピセン環、ペリレン環、ペンタフェン環、ペンタセン環、テトラフェニレン環、ヘキサフェン環、ヘキサセン環、ルビセン環、コロネン環、トリナフチレン環等が挙げられる。

好ましくはフェニル環、ナフチル環、アントラセン環、アセナフチレン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、ピレン環、クリセン環、ペリレン環、トリナフチレン環等が挙げられる。

さらに好ましくはフェニル環、ナフチル環、アントラセン環、フルオレン環、フェナントレン環、フルオランテン環、ピレン環、クリセン環、ペリレン環等が挙げられる。

[0031]

また、Xとして具体的には、置換若しくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基、置換若しくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基、置換若しくは無置換の炭素数1~50のアルキル基、置換若しくは無置換の炭素数1~50のア

ルコキシ基、置換若しくは無置換の炭素数1~50のアラルキル基、置換若しくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基、置換若しくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基、置換若しくは無置換の炭素数1~50のカルボキシル基、置換又は無置換のスチリル基、ハロゲン基、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基等である。

[0032]

置換若しくは無置換の核炭素数 6~50の芳香族基の例としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピフェニルイル基、9ーターフェニルイル基、4ーピフェニルイル基、pーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリルフェニル基、pートリル基、pートリル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4・メチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4・メチルビフェニルイル基、9、9ージメチルー2ーフルオレニル基、3ーフルオランテニル基等が挙げられる。

[0033]

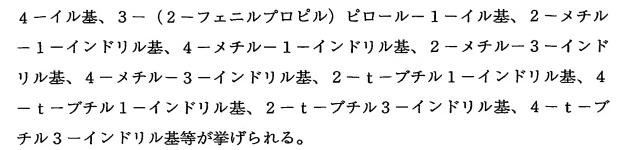
好ましくは、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピフェニルイル基、3ーピフェニルイル基、4ーピフェニルイル基、0ートリル基、mートリル基、pートリル基、pートリル基、pーtープチルフェニル基、2ーフルオレニル基、9,9ージメチルー2ーフルオレニル基、3ーフルオランテニル基等が挙げられる。

[0034]

置換若しくは無置換の核原子数5~50の芳香族複素環基の例としては、1-

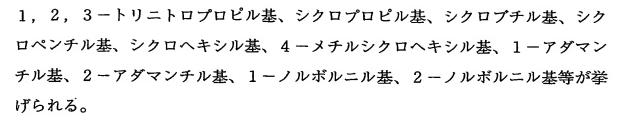
ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル 基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル 基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル 基、7ーインドリル基、1ーイソインドリル基、2ーイソインドリル基、3ーイ ソインドリル基、4ーイソインドリル基、5ーイソインドリル基、6ーイソイン ドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフ ラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル 基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基 、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラ ニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、キノリル基、 3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノ リル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソ - キノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、 8ーイソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノ キサリニル基、1-カルバブリル基、2-カルバブリル基、3-カルバブリル基 、4ーカルバゾリル基、9ーカルバゾリル基、1ーフェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基 、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジ ニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリ ジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9 ーアクリジニル基、1, 7ーフェナンスロリンー2ーイル基、1, 7ーフェナン スロリンー3ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、1,7ーフェ ナンスロリンー5ーイル基、1, 7ーフェナンスロリンー6ーイル基、1, 7ー フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基 、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イ ル基、1,8ーフェナンスロリンー5ーイル基、1,8ーフェナンスロリンー6 ーイル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン- 10 - イル基、1, 9 - フェナンス

ロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナ ンスロリンー4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フ ェナンスロリンー6ーイル基、1、9ーフェナンスロリンー7ーイル基、1、9 -フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、 1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリ ンー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー1ーイル基、2,9ーフェナンス ロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナ ンスロリンー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,9-フ ェナンスロリンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,9 -フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、 2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル 基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2.8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8ーフェナンスロリンー7ーイル基、2,8ーフェナンスロリンー 9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロ リンー1ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー3ーイル基、2,7ーフェナン スロリンー4ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー5ーイル基、2,7ーフェ ナンスロリンー6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリンー9ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー10-イル基、1 ーフェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノ チアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、10-フェ ノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェ ノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、10-フェノキサジニル基、2-オ キサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリ ル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエ ニル基、2-メチルビロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル基、 2-メチルビロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチ ルビロールー1ーイル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロー ルー4ーイル基、3-メチルピロールー5-イル基、2-t-プチルピロールー



[0035]

置換若しくは無置換の炭素数1~50のアルキル基の例としては、メチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブ チル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n ーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシ エチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーtーブチル基、1, 2. 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2 ークロロエチル基、2ークロロイソブチル基、1,2ージクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロローt-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチ ル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモ イソプロピル基、2,3ージブロモーtーブチル基、1,2,3ートリブロモプ ロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨ ードイソブチル基、1,2ージヨードエチル基、1,3ージヨードイソプロピル 基、2,3-ジヨードーt-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、ア ミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチ ル基、1.2-ジアミノエチル基、1.3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノー t ープチル基、1, 2, 3 ートリアミノプロピル基、シアノメチル基 、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2 ージシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3-ジシアノー t ープチル基、1, 2, 3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロ エチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエ チル基、1,3-ジニトロイソプロビル基、2,3-ジニトローtーブチル基、



[0036]

置換若しくは無置換の炭素数1~50のアルコキシ基は一〇Yで表される基で あり、Yの例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n ーブチル基、sーブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、nーペンチル基、n ーヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒドロキシメチル基、1ーヒ ドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1 ,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシー t ーブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロ メチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基 、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2.3-ジク ロロー t ープチル基、1, 2, 3 ートリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1 ーブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジ ブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2.3-ジブロモーt-ブ チル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチ ル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル 基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2,3-ジヨードーt-ブチル基、1, 2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2, 3ージアミノーt-ブチル基、1, 2, 3ートリ アミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基 、2-シアノイソプチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソ プロピル基、2,3ージシアノーtープチル基、1,2,3ートリシアノプロピ ル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロ イソプチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、 2, 3-ジニトローtーブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げ



[0037]

置換若しくは無置換の炭素数1~50のアラルキル基の例としては、ベンジル 基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル 基、2-フェニルイソプロピル基、フェニル-t-ブチル基、α-ナフチルメチ ル基、 $1-\alpha$ ーナフチルエチル基、 $2-\alpha$ ーナフチルエチル基、 $1-\alpha$ ーナフチ ルイソプロピル基、2-αーナフチルイソプロピル基、βーナフチルメチル基、 $1-\beta$ ーナフチルエチル基、 $2-\beta$ ーナフチルエチル基、 $1-\beta$ ーナフチルイソ プロピル基、2-β-ナフチルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1 ーピロリル) エチル基、pーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、oー メチルベンジル基、pークロロベンジル基、mークロロベンジル基、oークロロ ベンジル基、pーブロモベンジル基、mーブロモベンジル基、oーブロモベンジ ル基、pーヨードベンジル基、mーヨードベンジル基、 o ーヨードベンジル基、 p-ヒドロキシベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、 o-ヒドロキシベンジ ル基、pーアミノベンジル基、mーアミノベンジル基、oーアミノベンジル基、 p-ニトロベンジル基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-シ アノベンジル基、mーシアノベンジル基、 o ーシアノベンジル基、 1 ーヒドロキ シー2-フェニルイソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等 が挙げられる。

[0038]

置換若しくは無置換の核原子数5~50のアリールオキシ基は-OY'と表され、Y'の例としてはフェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、3ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイ

ル基、oートリル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチルフェニル基 、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4 ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフ ェニルイル基、4"ーtーブチルーp-ターフェニルー4ーイル基、2ーピロリ ル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、 4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、 5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル 基、3ーイソインドリル基、4ーイソインドリル基、5ーイソインドリル基、6 ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリル基、3ーフリル基、2 ーベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベン ゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾ フラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソ ベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2 ーキノリル基、3ーキノリル基、4ーキノリル基、5ーキノリル基、6ーキノリ ル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1ーイソキノリル基、3ーイソキノリ ル基、4ーイソキノリル基、5ーイソキノリル基、6ーイソキノリル基、7ーイ ソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニ ル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4ーカルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナ ンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基 、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル 基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アク リジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリ ンー3-イル基、1,7-フェナンスロリンー4-イル基、1,7-フェナンス ロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナ ンスロリンー8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フ ェナンスロリンー10-イル基、1,8-フェナンスロリンー2-イル基、1, 8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、

1.8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル 基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナンスロリン -2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロ リンー4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナン スロリンー6ーイル基、1,9ーフェナンスロリンー7ーイル基、1,9ーフェ ナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,1 0-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基 -イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン- 4 - イル基、2, 9 - フェナンスロ リンー5ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー6ーイル基、2,9ーフェナン スロリンー7ーイル基、2,9ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,9ーフェ ナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8 ーフェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2 ,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基 、2、8-フェナンスロリンー7-イル基、2、8-フェナンスロリンー9-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1ーイル基、2, 7ーフェナンスロリンー3ーイル基、2, 7ーフェナンスロリ ン-4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンス ロリンー6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナ ンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェ ナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジ ニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジ ニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジ ル基、3ーメチルピロールー1ーイル基、3ーメチルピロールー2ーイル基、3ーメチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2ーtーブチルピロールー4ーイル基、3ー(2ーフェニルプロピル)ピロールー1ーイル基、2ーメチルー1ーインドリル基、4ーメチルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル基、4ーメチルー3ーインドリル基、2ーtーブチル1ーインドリル基、4ーtーブチル1ーインドリル基等が挙げられる。

[0039]

置換若しくは無置換の核原子数5~50のアリールチオ基は-SY"と表され 、Y"の例としてはフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アント リル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フ エナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナン トリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1 ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2ービフェニルイル基、3ー ビフェニルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、p - ターフェニルー3-イル基、p-ターフェニルー2-イル基、m-ターフェニ ルー4ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル 基、oートリル基、mートリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、 p-(2-7) エニルプロピル)フェニル基、3-3 チルー2-7 ナフチル基、4-メチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4'ーメチルビフェ ニルイル基、4"ーtーブチルーpーターフェニルー4ーイル基、2ーピロリル 基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4 ーピリジニル基、2ーインドリル基、3ーインドリル基、4ーインドリル基、5 ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル基、1ーイソインドリル基 、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリル基、3ーフリル基、2ー ベンゾフラニル基、3ーベンゾフラニル基、4ーベンゾフラニル基、5ーベンゾ フラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフ ラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベ

ンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル 基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル 基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソ キノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル 基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カ ルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナン スリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フ ェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、 9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基 、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリ ジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン -3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1, 7-フェナンスロ リン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナン スロリンー8ーイル基、1,7ーフェナンスロリンー9ーイル基、1,7ーフェ ナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8 ーフェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1 , 8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基 、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イ ル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリ ン-4-イル基、1、9-フェナンスロリン-5-イル基、1、9-フェナンス ロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナ ンスロリン-8-イル基、1、9-フェナンスロリン-10-イル基、1、10 ーフェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、 1, 10-フェナンスロリン-4-イル基、1, 10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9ーフェナンスロリン-1-イル基、2,9ーフェナンスロリンー 3-イル基、2、9-フェナンスロリン-4-イル基、2、9-フェナンスロリ ン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンス

ロリン-7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナ ンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリンー3ーイル基、2.8ーフェナンスロリンー4ーイル基、2. 8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、 2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル 基、2、8-フェナンスロリン-10-イル基、2、7-フェナンスロリン-1 ーイル基、2,7ーフェナンスロリン-3ーイル基、2,7ーフェナンスロリン -4-イル基、2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェナンスロ リンー6ーイル基、2,7ーフェナンスロリンー8ーイル基、2,7ーフェナン スロリン-9-イル基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナ ジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニ ル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニ ル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニ ル基、2ーオキサゾリル基、4ーオキサゾリル基、5ーオキサゾリル基、2ーオ キサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル 基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロールー4-イル基、2-メチルピロールー5-イル 基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロールー4ーイル基、3ーメチルピロールー5ーイル基、2-tーブチ ルピロールー4ーイル基、3ー(2ーフェニルプロピル)ピロールー1ーイル基 、2-メチルー1-インドリル基、4-メチルー1-インドリル基、2-メチル - 3 - インドリル基、 4 - メチルー 3 - インドリル基、 2 - t - ブチル 1 - イン ドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基 、4-t-ブチル3-インドリル基等が挙げられる。

[0040]

置換若しくは無置換の炭素数 $1\sim50$ のカルボキシル基は-COOZと表され、Zの例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル

シエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1、3ージヒドロキシイソプロピル基、2、3ージヒド ロキシー t ーブチル基、1, 2, 3 ートリヒドロキシプロピル基、クロロメチル 基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1. 2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロー t-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロ モエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモ エチル基、1,3ージブロモイソプロピル基、2,3ージブロモー tーブチル基 、1,2,3ートリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、 2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1 3 - ジョードイソプロピル基、2,3 - ジョードー t - ブチル基、1,2,3 ートリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエ チル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミ ノイソプロピル基、2,3ージアミノーtーブチル基、1,2,3ートリアミノ プロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピ ル基、2,3-ジシアノーtーブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、 ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブ チル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3 ージニトローtーブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられる

[0041]

置換又は無置換のスチリル基の例としては、2-フェニル-1-ビニル基、2, 2-ジフェニル-1-ビニル基、1, 2, 2-トリフェニル-1-ビニル基等が挙げられる。

ハロゲン基の例としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。

[0042]

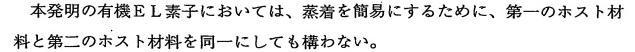
mは1~2、nは0~4が好ましい。

一般式[1]の化合物の具体例を以下に示す。

[0043]

【化4】

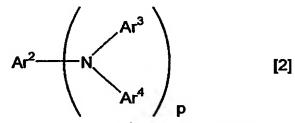
[0044]



[0045]

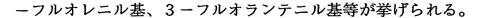
第一発光層と第二発光層に用いられるドーパントは、それぞれ長寿命な発光材料として公知のものを用いることが可能であるが、一般式 [2] で示される材料を発光材料のドーパント材料として用いることが好ましい。

【化5】



[0047]

置換若しくは無置換の核炭素数6~50の芳香族基の例としては、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、1ーアントリル基、2ーアントリル基、9ーアントリル基、1ーフェナントリル基、2ーフェナントリル基、3ーフェナントリル基、4ーフェナントリル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピフェルイル基、2ーピフェニルイル基、3ービフェニルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー4ーイル基、pーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー4ーイル基、mーターフェニルー3ーイル基、mーターフェニルー2ーイル基、mートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pートリル基、pーナフチルフェニル基、pー(2ーフェニルプロピル)フェニル基、3ーメチルー2ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、4、ーメチルビフェニルイル基、4、1・ロブチルーフーターフェニルー4ーイル基、2ーフルオレニル基、9、9ージメチルー2



[0048]

好ましくは、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、9ーフェナントリル基、1ーナフタセニル基、2ーナフタセニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2ーピレニル基、3ーピフェニルイル基、3ーピフェニルイル基、4ーピフェニルイル基、0ートリル基、mートリル基、pートリル基、pートリル基、2ーフルオレニル基、9,9ージメチルー2ーフルオレニル基、3ーフルオランテニル基等が挙げられる。

[0049]

置換又は無置換のスチリル基の例としては、2-フェニル-1-ビニル基、2,2-ジフェニル-1-ビニル基、1,2,2-トリフェニル-1-ビニル基等が挙げられる。

一般式 [2] の化合物の具体例、及びその他ドーパントとして好適な化合物の例を以下に示す。尚、式中において、Meはメチル基を、Etはエチル基を表す

[0050]

【化6】

[0051]

第一ホスト材料に対する前記第一ドーパントの割合は、0.1~10mol%、特に1~10mol%であることが好ましい。0.1mol%より小さいと、十分な発光が得られず、10mol%を超えると濃度消光を起こし、発光効率が

低下するおそれがある。

また、第二ホスト材料に対する前記第二ドーパントの割合は、0.1~10m o 1%、特に0.1~5mo1%であることが好ましい。

第一発光層の膜厚は、10nm以上、特に10nm~40nmが好ましい。10nm未満では、第二発光層まで十分な濃度の正孔が到達し、第二発光層が必用以上に発光し、色純度を悪くするおそれがある。従って、第一発光層を、第二発光層より厚くできる。

第二発光層の膜厚は、第一発光層に合わせて調製するが、好ましくは、 $10nm \sim 40nm$ 、特に $10nm \sim 30nm$ が好ましい。

[0052]

発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピンコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。発光層は、特に分子堆積膜であることが好ましい。

ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着され形成された薄膜や、溶液状態又は液相状態の材料化合物から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。

また、特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着 剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等によ り薄膜化することによっても、発光層を形成することができる。

[0053]

本発明の有機EL素子の構成及び発光層以外の構成要素について、以下に説明する。

本発明の作用効果を損なわない限り、第一発光層と第二発光層の間、陽極と第

- ii) 陽極/正孔注入層/第一発光層/第二発光層/陰極
- iii) 陽極/第一発光層/第二発光層/電子注入層/陰極
- iv) 陽極/正孔注入層/第一発光層/第二発光層/電子注入層/陰極
- iv) 陽極/有機半導体層/第一発光層/第二発光層/陰極
- vi) 陽極/有機半導体層/電子障壁層/第一発光層/第二発光層/陰極
- vii) 陽極/有機半導体層/第一発光層/第二発光層/付着改善層/陰極
- viii) 陽極/正孔注入層/正孔輸送層/第一発光層/第二発光層/電子注入層/陰極
- ix) 陽極/絶緣層/第一発光層/第二発光層/絶緣層/陰極
- x) 陽極/無機半導体層/絶縁層/第一発光層/第二発光層/絶縁層/陰極
- xi) 陽極/有機半導体層/絶縁層/第一発光層/第二発光層/絶縁層/陰極
- xii) 陽極/絶縁層/正孔注入層/正孔輸送層/第一発光層/第二発光層 / 絶緣層/陰極
- xiii) 陽極/絶緣層/正孔注入層/正孔輸送層/第一発光層/第二発光層 /電子注入層/陰極

等の構造を挙げることができる。

これらの中で通常viii)の構成が好ましく用いられる。

[0054]

(1)透光性基板

本発明の有機EL素子は透光性の基板上に作製する。ここでいう透光性基板は有機EL素子を支持する基板であり、400~700nmの可視領域の光の透過率が50%以上で、平滑な基板が好ましい。

具体的には、ガラス板、ポリマー板等が挙げられる。ガラス板としては、特に ソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノ ケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が挙げら れる。またポリマー板としては、ポリカーボネート、アクリル、ポリエチレンテ レフタレート、ポリエーテルサルファイド、ポリサルフォン等を挙げることがで きる。

[0055]

(2)陽極

有機薄膜EL素子の陽極は、正孔を正孔輸送層又は発光層に注入する役割を担うものであり、4.5 e V以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。また陰極としては、電子輸送層又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。

陽極はこれらの電極物質を蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることにより作製することができる。

このように発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率が10%より大きくすることが好ましい。また陽極のシート抵抗は、数百Ω/□以下が好ましい。陽極の膜厚は材料にもよるが、通常10nm~1μm、好ましくは10~200nmの範囲で選択される。

[0056]

(3) 正孔注入、輸送層

正孔注入、輸送層は発光層への正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが通常 5.5 eV以下と小さい。このような正孔注入、輸送層としてはより低い電界強度で正孔を発光層に輸送する材料が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば、 $10^4 \sim 10^6 V/cm$ の電界印加時に、少なくとも $10^{-4} cm^2/V$ ・秒であれば好ましい。

正孔注入、輸送層を形成する材料としては、前記の好ましい性質を有するものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料として慣用されているものや、有機EL素子の正孔注入層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

[0057]

具体例として例えば、トリアゾール誘導体(米国特許3,112,197号明 細書等参照)、オキサジアゾール誘導体(米国特許3,189,447号明細書 等参照)、イミダゾール誘導体(特公昭37-16096号公報等参照)、ポリ

アリールアルカン誘導体(米国特許3,615,402号明細書、同第3,82 0,989号明細書、同第3,542,544号明細書、特公昭45-555号 公報、同51-10983号公報、特開昭51-93224号公報、同55-1 7105号公報、同56-4148号公報、同55-108667号公報、同5 5-156953号公報、同56-36656号公報等参照)、ピラゾリン誘導 体及びピラゾロン誘導体(米国特許第3,180,729号明細書、同第4,2 78,746号明細書、特開昭55-88064号公報、同55-88065号 公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同56-80 051号公報、同56-88141号公報、同57-45545号公報、同54 **-112637号公報、同55-74546号公報等参照)、フェニレンジアミ** ン誘導体(米国特許第3,615,404号明細書、特公昭51-10105号 公報、同46-3712号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53 435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参 照)、アリールアミン誘導体(米国特許第3,567,450号明細書、同第3 **,180,703号明細書、同第3,240,597号明細書、同第3,658** , 5 2 0 号明細書、同第 4 , 2 3 2 , 1 0 3 号明細書、同第 4 , 1 7 5 . 9 6 1 号明細書、同第4,012,376号明細書、特公昭49-35702号公報、 同39-27577号公報、特開昭55-144250号公報、同56-119 132号公報、同56-22437号公報、西独特許第1, 110, 518号明 細書等参照)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特許第3,526,501号明 細書等参照)、オキサゾール誘導体(米国特許第3,257,203号明細書等 に開示のもの)、スチリルアントラセン誘導体(特開昭56-46234号公報 等参照)、フルオレノン誘導体(特開昭54-110837号公報等参照)、ヒ ドラゾン誘導体(米国特許第3,717,462号明細書、特開昭54-591 43号公報、同55-52063号公報、同55-52064号公報、同55-4 6 7 6 0 号公報、同 5 5 - 8 5 4 9 5 号公報、同 5 7 - 1 1 3 5 0 号公報、同 57-148749号公報、特開平2-311591号公報等参照)、スチルベ ン誘導体(特開昭61-210363号公報、同第61-228451号公報、 同61-14642号公報、同61-72255号公報、同62-47646号

公報、同62-36674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93455号公報、同60-94462号公報、同60-174749号公報、同60-175052号公報等参照)、シラザン誘導体(米国特許第4,950,950号明細書)、ポリシラン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共重合体(特開平2-282263号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー(特にチオフェンオリゴマー)等を挙げることができる。

[0058]

正孔注入層の材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物(特開昭63-2956965号公報等に開示のもの)、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物(米国特許第4,127,412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

[0059]

また、米国特許第5,061,569号に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば、4,4'ービス(Nー(1ーナフチル)ーNーフェニルアミノ)ビフェニル(以下NPDと略記する)、また、特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4,4',4"ートリス(Nー(3ーメチルフェニル)ーNーフェニルアミノ)トリフェニルアミン(以下MTDATAと略記する)等を挙げることができる。

また、発光層の材料として示した前述の芳香族ジメチリディン系化合物の他、p型Si、p型SiC等の無機化合物も正孔注入層の材料として使用することができる。

[0060]

正孔注入、輸送層は上述した化合物を、例えば、真空蒸着法、スピンコート法

、キャスト法、LB法等の公知の方法により薄膜化することにより形成することができる。正孔注入、輸送層としての膜厚は特に制限はないが、通常は5nm~5μmである。この正孔注入、輸送層は正孔輸送帯域に本発明の化合物を含有していれば、上述した材料の一種又は二種以上からなる一層で構成されてもよいし、又は前記正孔注入、輸送層とは別種の化合物からなる正孔注入、輸送層を積層したものであってもよい。

また、有機半導体層は発光層への正孔注入又は電子注入を助ける層であって、 10⁻¹⁰ S/c m以上の導電率を有するものが好適である。このような有機半 導体層の材料としては、含チオフェンオリゴマーや特開平8-193191号公報に開示してある含アリールアミンオリゴマー等の導電性オリゴマー、含アリールアミンデンドリマー等の導電性デンドリマー等を用いることができる。

[0061]

(4) 電子注入層

電子注入層は発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着が良い材料からなる層である。

[0062]

電子注入層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン並びにその誘導体の金属錯体、又は含窒素複素環誘導体が好適である。

上記8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシン(一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン)のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物が挙げられる。

例えば、発光材料の項で記載したAlqを電子注入層として用いることができる。

一方、含窒素複素環誘導体としては、オキサジアゾール誘導体等がある。

オキサジアゾール誘導体としては、以下の一般式[3]~[5]で表される電子伝達化合物が挙げられる。

[0063]

【化7】

$$Ar^7$$
 Ar^8 Ar^9 [4]

$$Ar^{10}$$
 Ar^{11} O Ar^{12} Ar^{13} [5]

[式中Ar 5 , Ar 6 , Ar 7 , Ar 9 , Ar 10 , Ar 13 はそれぞれ置換又は無置換のアリール基を示し、それぞれ互いに同一であっても異なっていてもよい。また、Ar 8 , Ar 11 , Ar 12 は置換又は無置換のアリーレン基を示し、それぞれ同一であっても異なっていてもよい。〕

[0064]

ここで、アリール基としてはフェニル基、ビフェニル基、アントラニル基、ペリレニル基、ピレニル基が挙げられる。またアリーレン基としてはフェニレン基、ナフチレン基、ビフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン基、ピレニレン基等が挙げられる。また、置換基としては炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシ基又はシアノ基等が挙げられる。この電子伝達化合物は薄膜形成性のものが好ましい。

上記電子伝達性化合物の具体例としては、下記のものを挙げることができる。

[0065]

[化8]

[0066]

また、他の含窒素複素環誘導体有機化合物としては、一般式 [6] で表される 化合物が挙げられる。

【化9】

$$HAr - L^{1} - Ar^{14} - Ar^{15}$$
 [6]

(式中、HArは、置換基を有していても良い炭素数 $3\sim40$ の含窒素複素環であり、 L^1 は、単結合、置換基を有していてもよい炭素数 $6\sim60$ のアリーレン基、置換基を有していてもよい炭素数 $3\sim60$ のヘテロアリーレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、 Ar^{14} は、置換基を有していてもよい炭素数 $6\sim60$ の 2 価の芳香族炭化水素基であり、 Ar^{15} は、置換基を有していてもよい炭素数 $6\sim60$ のアリール基又は、置換基を有していてもよい炭素数 $3\sim60$ のヘテロアリール基である。)

[0067]

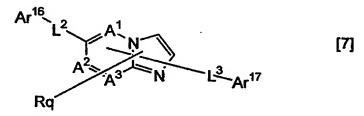
上記式 [6] の化合物は、特願2003-004139号に記載の方法によって合成できる。

この一般式 [6] の含窒素複素環誘導体有機化合物において、イミダゾピラジン誘導体、イミダゾール誘導体が好ましい。

[0068]

イミダゾピラジン誘導体としては、一般式[7]で表される化合物が挙げられる。

【化10】



(式中、 $A^1 \sim A^3$ は、窒素原子又は炭素原子であり、Rは、置換基を有してい てもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有していてもよい炭素数3~6 0のヘテロアリール基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のハロア ルキル基、炭素数1~20のアルコキシ基であり、aは0から5の整数であり、 qが2以上の整数であるとき、複数のRは互いに同一又は異なっていてもよい。 また、隣接する複数のR基同士で互いに結合して、置換又は未置換の炭素環式脂 肪族環、あるいは、置換又は未置換の炭素環式芳香族環を形成していてもよい。 Ar¹⁶は、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を 有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリール基であり、Ar17は、水素 原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のハロアルキル基、炭素数 1~20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール 基、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロアリール基であり、(た だし、Ar¹⁶、Ar¹⁷のいずれか一方は置換基を有していてもよい炭素数1 0~60の縮合環基、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロ縮合環 基である)。 L^2 、 L^3 は、それぞれ単結合、置換基を有していてもよい炭素数 6~60の縮合環、置換基を有していてもよい炭素数3~60のヘテロ縮合環又 は置換基を有していてもよいフルオレニレン基である。)

[0069]

上記式 [7] の化合物は、特願2003-005184号に記載の方法によって合成できる。

[0070]

イミダゾール誘導体としては、一般式[8]又は[9]で表される化合物が挙 げられる。

【化11】

$$(R^{1})_{r}$$
 R^{2} R^{2} R^{19} [8]

$$(R^{1})_{r}$$

$$A^{18}$$

$$A^{19}$$

(式中、R¹は、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基で、rは0~4の整数であり、R²は、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基であり、R³は、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよい

キル基又は置換基を有していてもよい炭素数1~20のアルコキシ基であり、 L4は、置換基を有していてもよい炭素数6~60のアリーレン基、置換基を有 していてもよいピリジニレン基、置換基を有していてもよいキノリニレン基、置 換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、Ar¹⁸は、置換基を有して いてもよい炭素数6~60のアリーレン基、置換基を有していてもよいピリジニ レン基、置換基を有していてもよいキノリニレン基であり、Ar¹⁹は、置換基 を有していてもよい炭素数6~60のアリール基、置換基を有していてもよいピ リジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよいピ リジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭 素数1~20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1~20のアル コキシ基である。)

[0071]

上記式[8] の化合物は、特願2003-67847号に記載の方法によって 合成できる。

含窒素複素環誘導体有機化合物の具体例を下記に示す。

【化12】

[0072]

本発明において、電子注入層は、電界強度(E)が $10^4 \sim 10^6 \text{ V/cm}$ の領域において、電子移動度が $10^{-4} \text{ cm}^2 \text{/} (\text{V} \cdot \text{秒})$ 以上であることが好ましい。このような電子移動度を有する有機化合物を電子注入層に用いることで、有機EL素子の駆動電圧の低電圧化が図れる。

さらに、発光領域を陽極側である第一発光層にシフトすることができるため、 第二発光層の発光を抑制できることから、より色純度のよいナローバンド発光が 得られ、高効率かつ、長寿命にすることができる。

[0073]

このため、電子注入層には、電子移動度が特に高い化合物、例えば、上述の含 窒素複素環誘導体有機化合物、特に、イミダゾピラジン誘導体及び/又はイミダ ゾール誘導体を使用することが特に好ましい。

尚、上記の化合物は、必要に応じて積層、混合等の形態をとって電子注入層を 形成してもよい。

[0074]

本発明の好ましい形態に、電子を輸送する領域又は陰極と有機層の界面領域に、還元性ドーパントを含有する素子がある。ここで、還元性ドーパントとは、電子輸送性化合物を還元ができる物質と定義される。従って、一定の還元性を有するものであれば、様々なものが用いられ、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属の酸化物又は希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属の有機錯体、アルカリ土類金属の有機錯体、希土類金属の有機錯体がらなる群から選択される少なくとも一つの物質を好適に使用することができる。

[0075]

また、より具体的に、好ましい還元性ドーパントとしては、Na(仕事関数: 2.36 e V)、K(仕事関数: 2.28 e V)、Rb(仕事関数: 2.16 e V)及びCs(仕事関数: 1.95 e V)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属や、Ca(仕事関数: 2.9 e V)、Sr(仕事関数: 2.

 $0\sim2.5 \text{ eV}$)、及びB a(仕事関数:2.52 eV)からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属が挙げられる仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。これらのうち、より好ましい還元性ドーパントは、K、R b 及びC s からなる群から選択される少なくとも一つのアルカリ金属であり、さらに好ましくは、R b 又はC s であり、最も好ましのは、C s である。

[0076]

これらのアルカリ金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。また、仕事関数が2.9 e V以下の還元性ドーパントとして、これら2種以上のアルカリ金属の組み合わせも好ましく、特に、Csを含んだ組み合わせ、例えば、CsとNa、CsとK、CsとRb或いはCsとNaとKとの組み合わせであることが好ましい。Csを組み合わせて含むことにより、還元能力を効率的に発揮することができ、電子注入域への添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。

[0077]

本発明においては、陰極と有機層の間に絶縁体や半導体で構成される電子注入層をさらに設けても良い。この時、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらのアルカリ金属カルコゲナイド等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲナイドとしては、例えば、Li2〇、Li〇、Na2S、Na2Se及びNa〇が挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイドとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS、及びCaSeが挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiC1、KC1及びNaC1等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、CaF2、BaF2、SrF2、MgF2及びBeF2といったフッ化物

や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

[0078]

また、電子輸送層を設けてもよい。電子輸送層を構成する半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnの少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の一種単独又は二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子輸送層を構成する無機化合物が、微結晶又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子輸送層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。尚、このような無機化合物としては、上述したアルカリ金属カルコゲナイド、アルカリ土類金属カルコゲナイド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

[0079]

(5) 陰極

陰極としては仕事関数の小さい(4 e V以下)金属、合金、電気伝導性化合物 及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の 具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチ ウム、マグネシウム・銀合金、アルミニウム/酸化アルミニウム、アルミニウム ・リチウム合金、インジウム、希土類金属等が挙げられる。

この陰極はこれらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により薄膜を形成させることにより作製することができる。

ここで、発光層からの発光を陰極から取り出す場合、陰極の発光に対する透過率は10%より大きくすることが好ましい。

また、陰極としてのシート抵抗は数百 Ω / \square 以下が好ましく、膜厚は通常 10 $nm\sim 1~\mu$ m、好ましくは $50\sim 200$ n mである。

[0080]

(6) 絶縁層

有機EL素子は超薄膜に電界を印可するために、リークやショートによる画素 欠陥が生じやすい。これを防止するために、一対の電極間に絶縁性の薄膜層を挿 入することが好ましい。

絶縁層に用いられる材料としては例えば酸化アルミニウム、弗化リチウム、酸化リチウム、弗化セシウム、酸化セシウム、酸化マグネシウム、弗化マグネシウム、酸化カルシウム、弗化カルシウム、窒化アルミニウム、酸化チタン、酸化珪素、酸化ゲルマニウム、窒化珪素、窒化ホウ素、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化バナジウム等が挙げられる。

これらの混合物や積層物を用いてもよい。

[0081]

以上、例示した材料及び方法により陽極、発光層、必要に応じて正孔注入層、及び必要に応じて電子注入層を形成し、さらに陰極を形成することにより有機E L素子を作製することができる。また、陰極から陽極へ、前記と逆の順序で有機 EL素子を作製することもできる。

以下、透光性基板上に陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極が順次設けられた構成の有機EL素子の作製例を記載する。

[0082]

まず、適当な透光性基板上に陽極材料からなる薄膜を $1 \mu m$ 以下、好ましくは $10 \sim 200 nm$ の範囲の膜厚になるように蒸着やスパッタリング等の方法により形成して陽極を作製する。

次に、この陽極上に正孔注入層を設ける。正孔注入層の形成は、前述したように真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法等の方法により行うことができるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により正孔注入層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物(正孔注入層の材料)、目的とする正孔注入層の結晶構造や再結合構造等により異なるが、一般に蒸着源温度 $50\sim4$ 50 ℃、真空度 $10^{-7}\sim10^{-3}$ torr、蒸着速度 $0.01\sim50$ nm/秒、基板温度 $-50\sim300$ ℃、膜厚5 nm ~5 μ mの範囲で適宜選択することが好ましい。

[0083]

次に、正孔注入層上に発光層を設ける発光層の形成も、所望の有機発光材料を

用いて真空蒸着法、スパッタリング、スピンコート法、キャスト法等の方法により有機発光材料を薄膜化することにより形成できるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着法により形成することが好ましい。真空蒸着法により発光層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合物により異なるが、一般的に正孔注入層と同じような条件範囲の中から選択することができる。

[0084]

次に、この発光層上に電子注入層を設ける。正孔注入層、発光層と同様、均質な膜を得る必要から真空蒸着法により形成することが好ましい。蒸着条件は正孔注入層、発光層と同様の条件範囲から選択することができる。

最後に陰極を積層して有機EL素子を得ることができる。

陰極は金属から構成されるもので、蒸着法、スパッタリングを用いることができる。しかし、下地の有機物層を製膜時の損傷から守るためには真空蒸着法が好ましい。

これまで記載してきた有機EL素子の作製は一回の真空引きで一貫して陽極から陰極まで作製することが好ましい。

[0085]

本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。また、有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)或いは溶媒に解かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

[0086]

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数nmから 1μ mの範囲が好ましい。

尚、有機EL素子に直流電圧を印加する場合、陽極を+、陰極を-の極性にして、5~40 Vの電圧を印加すると発光が観測できる。また逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず、発光は全く生じない。さらに交流電圧を印加した場合に

は陽極が十、陰極が一の極性になった時のみ均一な発光が観測される。印加する 交流の波形は任意でよい。

[0087]

本発明の有機EL素子は、色純度のよいナローバンドの発光をし、特に青色発 光する素子として優れている。しかも、寿命も改善されている。

[0088]

【実施例】

以下、本発明の実施例を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されない。

尚、各実施例で使用した化合物の性質及び作製した素子は下記の方法で評価した。

- (1) エネルギーギャップ:ベンゼン中の吸収スペクトルの吸収端から測定した。具体的には、市販の可視紫外分光光度計を用いて吸収スペクトルを測定し、その吸収スペクトルが立ち上がり始める波長から算出する。
- (2) 輝度:分光放射輝度計(CS-1000、ミノルタ製)により測定した。
- (3)発光極大波長の発光強度:作製するEL素子と同じ条件で第一発光層及び 第二発光層の単層膜をそれぞれ作製し、市販の蛍光測定装置を用いてそれぞれの 単層膜の蛍光スペクトルを測定する。得られた第一発光層の蛍光スペクトルから 、第一発光層の発光極大波長 a において、第一発光層の蛍光強度 I a を測定する 。同様に、得られた第二発光層の蛍光スペクトルから、第二発光層の発光極大波 長りにおいて、第二発光層の蛍光強度 I b を測定する。

第一発光層と第二発光層の発光極大波長が十分に離れている場合は、EL素子の発光スペクトルにおける、a, bの波長における発光強度 I a, I bがそれぞれ I 1, I 2 と近似できる。

AL 76 11 - 1 41 . .

波長a, bの蛍光強度 I 2 a、 I 2 b を測定する。 I 1, I 2 について以下の式が成り立つ。

I a = I 1 * I 1 a + I 2 * I 2 a

I b = I 1 * I 1 b + I 2 * I 2 b

上記の式より I 1、 I 2 の比が求められる。

- (4) 発光効率:マルチメータを用いて測定した電流密度値と輝度(100nit)より算出した。
- (5) C. I. E色度座標: (2) と同様に測定して得られる。
- (6) 半減寿命:初期輝度1000nit、定電流条件下にて封止した素子に対し測定を行った。(室温)
- (7)電子移動度:Time of flight法により算出した。具体的には、ITO/有機層(電子注入層等、層厚 $1\sim2~\mu$ m)/Alo/構成としたものについて、光照射により生じる過渡電流の時間特性(過渡特性時間)を測定し、以下の式により電子移動度を算出した。

電子移動度= (有機層厚) 2/(過渡特性時間・電界強度)

[0089]

実施例において使用した化合物を以下に示す。

【化13】

TPD232

TBDB

D 1

H 1

ETM-020

D 2

[0090]

実施例1

25mm×75mm×1.1mm厚のITO透明電極付きガラス基板(ジオマティック社製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。

洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に前記透明電極を覆うようにして膜厚 60 nmoN, N'-ビス (N, N'-ジフェニルー4-アミノフェニル)-N, N-ジフェニルー4, <math>4'-ジアミノー1, 1'-ビフェニル膜 (以下「TPD232膜」と略記する。)を成膜した。このTPD232膜は、正孔注入層として機能する。

TPD232膜の成膜に続けて、TPD232膜上に膜厚20nmのN, N, N', N', -テトラ (4-ビフェニル) -ジアミノビフェニレン層 以下「TBDB層」を成膜した。この膜は正孔輸送層として機能する。

さらに、第一発光層のホスト材としてH1を、第一ドーパントとしてD1を、D1:H1の比が1.0:20(重量比)となるように蒸着し、膜厚20nmの層を形成した(第一ドーパント約5.4 モル%)。この層は第一発光層として機能する。

さらに、第二発光層のホスト材としてH1を、第二ドーパントとしてD2を、D2:H1の比が1.0:20(重量比)となるように蒸着し、膜厚20nmの層を形成した(第二ドーパント約5.7モル%)。この層は第二発光層として機能する。

この膜上に膜厚10 nmのAlq膜を成膜した。これは、電子注入層として機能する。

尚、Alqの電子移動度は、 5×10^{-6} c m $2 / (V \cdot 秒)$ である (E = 5×10^{5} V / c m)。

この後、還元性ドーパントであるLi(Li源:サエスゲッター社製)とAl qを二元蒸着させ、電子注入層(陰極)としてAl q:Li膜(膜厚10nm)を形成した。このAl q:Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機 E L 発光素子を形成した。

[0091]

実施例2

第一発光層の膜厚を10nm、D1:H1の比を0.3:10 (重量比)とし、第二発光層の膜厚を30nm、D2:H1の比を1.4:30 (重量比)とした以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作製した (第一ドーパント約3.3モル%、第二ドーパント約5.3モル%)。

[0092]

実施例3

第一発光層の膜厚を20nm、D1:H1の比を0.5:20 (重量比) とし、第二発光層の膜厚を20nm、D2:H1の比を1.0:20 (重量比) とした以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作製した (第一ドーパント約2.8モル%、第二ドーパント約5.7モル%)。

[0093]

実施例 4

第一発光層の膜厚を20nm、D1の代わりにD2を用い、D2:H1の比を1.0:20(重量比)とし、第二発光層の膜厚を20nm、D2の代わりにD3を用い、D3:H1の比を1.0:20(重量比)とした以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作製した(第一ドーパント約5.7モル%、第二ドーパント約4.8モル%)。

[0094]

実施例5

電子注入層を形成するAlqに代えて、ETM-020を使用した他は、実施例4と同様にして有機EL素子を作製した。

尚、ETM-020の電子移動度は、 4×10^{-4} c m 2 / $(V\cdot$ 秒) である $(E=5\times10^{5}$ V / c m) 。

[0095]

比較例1

第一発光層の膜厚を20nm、D1:H1の比を1.0:20(重量比)とし、第二発光層の膜厚を20nm、D2を用いなかった以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作製した(第一ドーパント約5.4モル%、第二ドーパント

0モル%)。

[0096]

比較例2

第一発光層の膜厚を20 n m、D1 の代わりにD2 を用い、D2: H1 の比を1.0:20 (重量比) とし、第二発光層の膜厚を20 n m、D2 を用いなかった以外は、実施例1 と全く同様に有機EL素子を作製した(第一ドーパント約5. 7 モル%、第二ドーパント0 モル%)。

[0097]

比較例3

第一発光層の膜厚を20nm、D1の代わりにD2を用い、D2:H1の比を 1.0:20 (重量比) とし、第二発光層の膜厚を20nm、D1:H1の比を 1.0:20 (重量比) とした以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作 製した (第一ドーパント約5.7モル%、第二ドーパント約5.4モル%)。

[0098]

比較例4

第一発光層の膜厚を20nm、D1の代わりにD3を用い、D3:H1の比を1.0:20(重量比)とし、第二発光層の膜厚を20nm、D2を用いなかった以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作製した(第一ドーパント約4.8モル%、第二ドーパント0モル%)。

[0099]

比較例5

第一発光層の膜厚を20nm、D1の代わりにD3を用い、D3:H1の比を1.0:20 (重量比) とし、D2:H1の比を1.0:20 (重量比) とした以外は、実施例1と全く同様に有機EL素子を作製した (第一ドーパント約4.8モル%、第二ドーパント約5.7モル%)。

[0100]

比較例6

第二発光層を、第一発光層と同じ構成にした他は、実施例 5 と同様にして有機 E L 素子を作製した。

ページ: 67/

[0101]

実施例1~5及び比較例1~6で作製した有機EL素子について、各有機EL素子の発光層の構成、第一発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度(I1)及び前記第二発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度(I2)の比(I1/I2)、初期の発光効率、C. I. E色度座標及び半減寿命を測定した。表1に結果を示す。

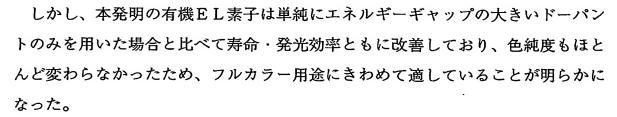
[0102]



		γ				
	第一発光層	第二発光層	11/	発光効率	C. I. E 色度	半旗
	(Egh/Egd1)	(Egh/Egd2)	I 2	(cd/A)	座標	寿命
実施例	H1/D1	H1/D2	80/20	6.7	0. 15, 0. 17	3,000
1	(3.0eV/2.9eV)	(3.0eV/2.8eV)				
実施例	H1/D1	H1/D2	55/45	7.4	0. 15, 0. 20	3, 500
2	(3.0eV/2.9eV)	(3. 0eV/2. 8eV)				
実施例	HI/DI	H1/D2	80/20	6.3	0. 15, 0. 16	2,500
3	(3.0eV/2.9eV)	(3.0eV/2.8eV)				
比較例	H1/D1	H1	100/0	. 5. 3	0. 15, 0. 15	1,500
1	(3.0eV/2.9eV)	(3. 0eV)				
比較例	H1/D2	H1	100/0	11.5	0.16.0.31	3, 700
2	(3.0eV/2.8eV)	(3. 0eV)				
比較例	H1/D2	H1/D1	100/0	11.9	0.16,0.30	2.900
3	(3.0eV/2.8eV)	(3. 0eV/2. 9eV)				
実施例	H1/D2	H1/D3	90/10	6. 8	0. 25. 0. 26	13,000
4	(3.0eV/2.8eV)	(3.0eV/2.6eV)				
比較例	H1/D3	H1	100/0	8. 2	0.50,0.48	15,000
4	(3.0eV/2.6eV)	(3.0eV)				
比較例	H1/D3	H1/D2	100/0	8.3	0. 49, 0. 48	14,000
5	(3.0eV/2.6eV)	(3. 0eV/2. 8eV)				
実施例	H1/D2	H1/D3	100/0	13.5	0.16,0.31	8,000
5	(3.0eV/2.8eV)	(3.0eV/2.6eV)				
比較例	H1/D2	H1/D2	100/0	10.0	0.16,0.31	1,500
6	(3.0eV/2.8eV)	(3. 0eV/2. 8eV)				

[0103]

表1から判るように、エネルギーギャップの大きいドーパントのみを用いた有機EL素子は、色純度は良好であるが発光効率が低く、半減寿命も短かった。逆に、エネルギーギャップが小さいドーパントのみを用いた有機EL素子は発光効率が高く半減寿命も長いが、色純度は悪くフルカラー用途には適さなかった。



さらに、実施例 5 及び比較例 6 において、電子注入層に、電子移動度が高い E TM-020を使用したことで、第一発光層のみを発光させること(I 2=0)ができた。この場合において、第一ドーパントと第二ドーパントのエネルギーギャップが、本発明の要件を満たすことによって、半減寿命を著しく向上でき、本発明の効果は絶大であることが確認できた。

[0104]

【発明の効果】

本発明によれば、色純度の高いナローバンド発光をし、長寿命である有機EL 素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の有機EL素子の概略断面図である。

[図2]

本発明の有機EL素子のエネルギーダイアグラムである。

【図3】

一般的な有機EL素子の概略断面図である。

【図4】

有機EL素子のエネルギーダイアグラムである。

【図5】

ドーパントが添加された有機EL素子のエネルギーダイアグラムである。

【符号の説明】

- 1 有機EL素子
- 2 陽極
- 3 第一発光層
- 4 第二発光層

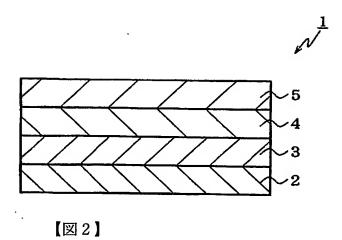
5 陰極

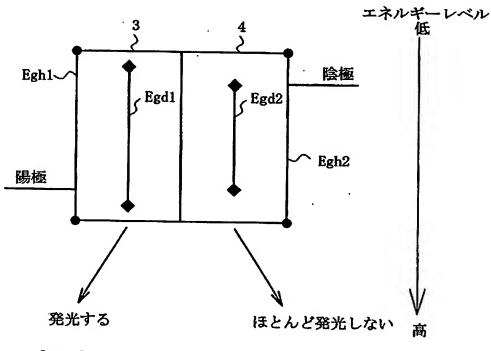
- Egh1 第一ホスト材料のエネルギーギャップ
- Egd1 第一ドーパントのエネルギーギャップ
- Egh2 第二ホスト材料のエネルギーギャップ
- E_{gd2} 第二ドーパントのエネルギーギャップ



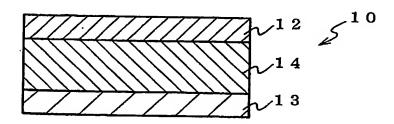
図面

【図1】

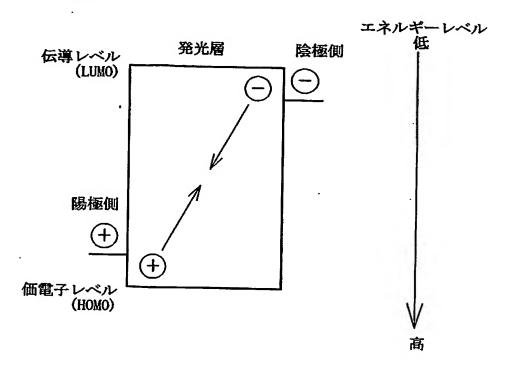




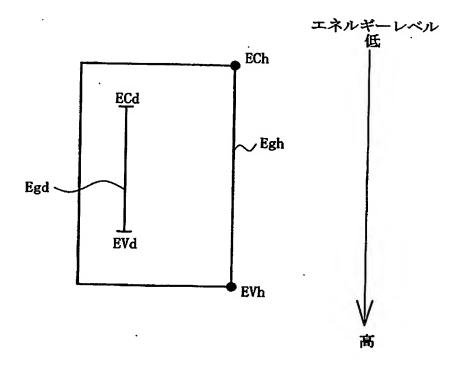
【図3】



【図4】



【図5】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 色純度の高いナローバンド発光をし、長寿命である有機EL素子を提供する。

【解決手段】 陽極と、少なくとも第一ホスト材料と第一ドーパントからなる第一発光層と、少なくとも第二ホスト材料と第二ドーパントからなる第二発光層と、陰極と、をこの順序に含み、第一ホスト材料のエネルギーギャップ $E_{gh}1$ 、第一ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 及び第二ドーパントのエネルギーギャップ $E_{gh}2$ 0が下記式を満たし、かつ、第一発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 $I_{gh}2$ 0が第二発光層に由来する発光スペクトルの発光極大波長の発光強度 $I_{gh}2$ 1を満たすことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

E g h 1 > E g d 1
E g h 2 > E g d 2
E g d 1 > E g d 2

 $I1>3.5\times I2$

【選択図】 図2

特願2003-152276

出願人履歴情報

識別番号

[000183646]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月 8日 新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

氏 名 出光興産株式会社